

InGaAs PIN фотодиод 2 мм, ТО-корпус — техническое описание

P/N :WIT3-2000B

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая чувствительность
- Низкий темновой ток
- Спектральная чувствительность 800–1740 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

- Газовые сенсоры; оптические датчики; измерители оптической мощности
- Промышленная автоматика; аппаратура регистрации излучения; измерение спектральной чувствительности

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.
Рабочая температура	TSTG	°C	-40	85
Температура хранения	TC	°C	-40	85
Температура (время) пайки	TL	°C		260 / 10 с
Обратное напряжение	VCC	B		4

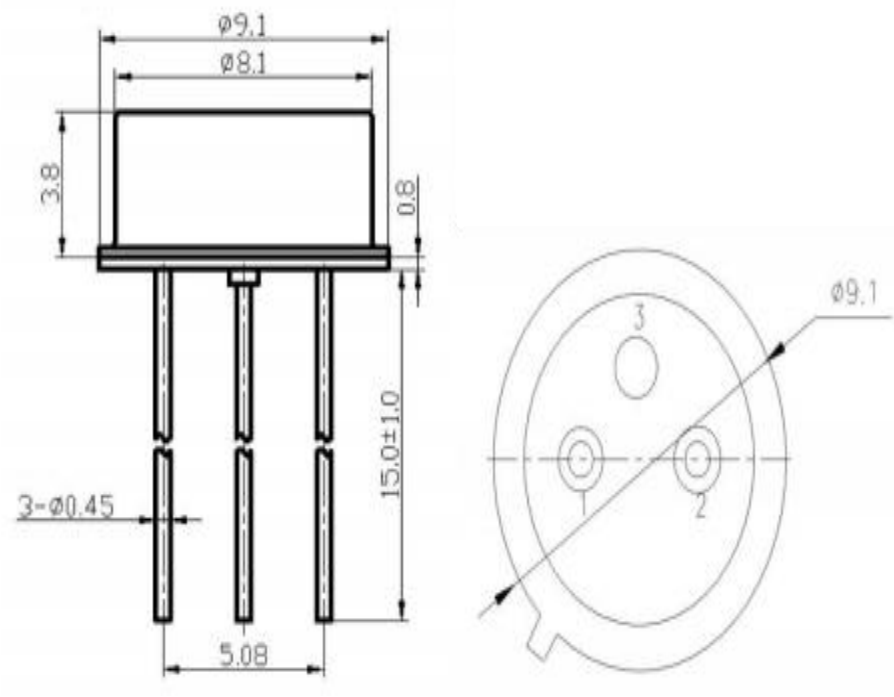
Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	D	-	-	2000	-	мкм
Чувствительность	R	$\lambda = 1310\text{nm}$	0.8	0.85	-	A/Bт
		$\lambda = 1550\text{nm}$	0.8	0.90	-	A/Bт
Темновой ток	ID	VBR=-5V	-		20	нА
Спектральная чувствительность	λ	-	800	-	1740	нм
Емкость	C	VBR=-5V		160	230	пФ

ПРИМЕЧАНИЕ

При хранении, транспортировке и использовании рекомендуются соответствующие меры защиты от ЭСР.

Назначение выводов и габаритный чертёж:



№ вывода	Название
1	PD+
2	PD-
3	GND